

ПОЛЮС БАС

**Установка для ПХ зачистки
поверхности CRF-VPO-100L**

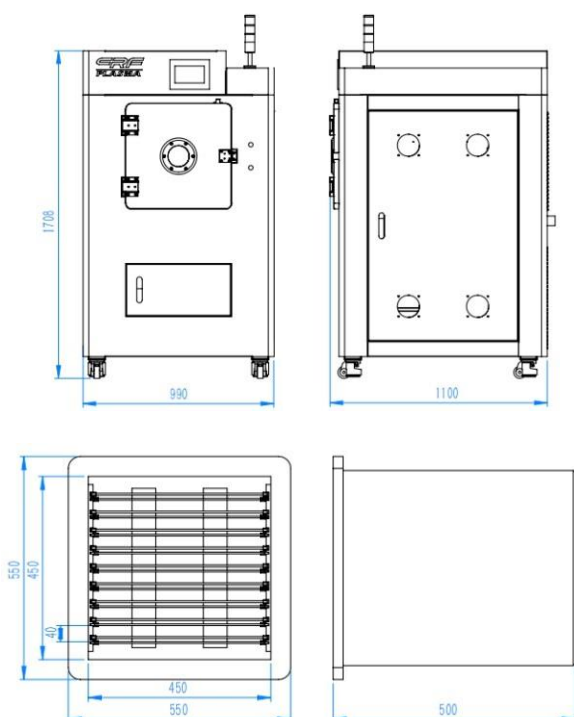
**Техническая
информация**

Установка для ПХ зачистки поверхности CRF-VPO-100L



Установка для ПХ зачистки поверхности CRF-VPO-100L использует методику плазменной очистки. Сферы её применения: упаковка полупроводников, производство гибких печатных плат, энергетика, машиностроение, производство различных электронных устройств, медицинского оборудования и инструментов.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



Установка для ПХ зачистки поверхности CRF-VPO-100L

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемые изделия	подложки, корпуса и рамки микросхем
Объём реактивной камеры, л	100
Габаритные размеры установки, мм	990 x 1100 x 1708
Габаритные размеры камеры, мм	450 x 500 x 450
Масса, кг	500
Потребляемая мощность, кВт	4,5
Рабочее напряжение, В	380 (переменный ток 50Гц)
Система управления	PLC+HMI (Mitsubishi)
Генератор плазмы	CRF мощностью 0-600 Вт (полностью автоматическая система)
Система контроля вакуума	цифровой вакуумметр Пирани
Система газорегулирования	управление двусторонним электромагнитным клапаном
Количество электродных слоев	8-слойная горизонтальная электродная пластина
Эффективная зона обработки, мм	370 x 440
Газовый канал	стандартный двусторонний канал с выбором газов: сжатый воздух, кислород, аргон, азот, четырехфтористый углерод и т.д.
Рабочий вакуум, Па	5 - 50
Время вакуумной откачки, с	≤ 60
Сброс вакуума, с	≤ 15
Регулирование массового расхода, ссст	0 - 300
Время очистки, с	60 – 120 (настраиваемый параметр)
Диапазон давления в реакционной камере, Па	0,5 - 30
Расход сжатого воздуха, л/мин.	1-10
Вакуумный насос	TVP90m ³ /h
Манометр	SMC

ПОЛЮС БАС

☎ +7 (499) 444-70-45

✉ info@polusbas.ru 🌐 www.polusbas.ru